

FOR USE BY ELECTRICIANS OVERSEAS:

最新トランジスタ規格表 (New Transistor Manual) lists all the transistors registered with the Electronic Industries Association of Japan (EIAJ), arranged in a manner easy to look up. We hope that you will make full use of the data provided in this manual by referring to the Japanese-English translation key given below.

型名	社名	用途	構造	最大定格 ($T_a=25^{\circ}\text{C}$)					電気的特性 ($T_a=25^{\circ}\text{C}$)										外形	備考
				V_{ceo} (V)	V_{cso} (V)	I_c (mA)	P_c (mW)	T_j ($^{\circ}\text{C}$)	I_{cso} 最大値 (μA)	$V_{ce(V)}$	直流又はパルス h_{FE} I_c (mA)	バイアス $V_{ce(V)}$	h_{FE} h_{FE} *	h_{ie} h_{ie} * (Ω)	h_{re} h_{re} * ($\times 10^{-4}$)	h_{oe} h_{oe} * (μS)	f_{α} f_{α} * (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $r_{bb'}$ (real)* (Ω)	
1	2	3	4	5					6	7		8			9			10	11	12

- 1 TYPE NUMBER
- 2 ORIGINAL MANUFACTURER
- 3 USES
- 4 MATERIAL AND STRUCTURE
- 5 MAXIMUM RATINGS
- 6 I_{cso} MAXIMUM VALUE AND V_{ce} VALUE (CRITERIA FOR MEASURING I_{cso})
- 7 STANDARD VALUE OF DC/PULSE h_{FE} AND V_{ce} , I_c (CRITERIA FOR MEASURING DC/PULSE h_{FE})
- 8 STANDARD VALUE OF h PARAMETERS AND BIAS V_{ce} , I_c (CRITERIA FOR MEASURING h PARAMETERS)

* INDICATES VALUE IN GROUNDED-BASE OPERATION, OTHERWISE VALUE IN EMITTER-GROUNDED OPERATION.

- 9 f_{α} OF RF CHARACTERISTIC, EXCEPT IN CASE OF * WHICH INDICATES VALUE OF f_T .
- 10 C_{ob} AND $r_{bb'}$ OF RF CHARACTERISTICS EXCEPT IN CASE OF * IN $r_{bb'}$ COLUMN WHICH INDICATES VALUE OF h_{ie} (real)
- 11 OUTLINE
- 12 REMARKS

: とコンプリ: COMPLEMENTARY TO

型 名	社 名	用 途	構 造	最 大 定 格 ($T_a = 25^{\circ}\text{C}$)					電 気 的 特 性 ($T_a = 25^{\circ}\text{C}$)											外 形	備 考			
				V_{CB0} (V)	V_{EB0} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j ($^{\circ}\text{C}$)	I_{CB0} 最大値		直 流 又 は パ ル ス h_{FE}			バ イ ア ス			h_{fe}	h_{ie} h_{ib}^* (Ω)	h_{re} h_{rb}^* ($\times 10^{-4}$)			h_{oe} h_{ob}^* (μS)	$f_{\alpha b}$ f_T^* (Mc)	C_{ob} (pF)
2SD627	三 洋	SW	Si.TMe	1500	6	3 A	50W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	50	1000	5~25	10	2 A			$t_f < 1 \mu\text{S}$							102	
" 628	日 立	PA	Si.EPa	100	7	10A	80W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	100	100	1000~ 2000	3	5 A			$t_{on} = 2 \mu\text{S}$, $t_{off} = 8 \mu\text{S}$							102	ターリントン
" 629	"	"	"	100	7	10A	100W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	100	100	1000~ 2000	3	5 A			$t_{on} = 2 \mu\text{S}$, $t_{off} = 8 \mu\text{S}$							102	ターリントン
" 630	富士通	"	Si.DJ	50	5	30A	200W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	175	100	30	25	5	15A										299	
" 631	"	"	"	60	5	40A	200W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	175	100	30	40	5	15A										299	
" 632	松 下	"	Si.TMe	350	5	2.5A	80W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	1mA	350	120	15	500										102	
" 633	東 芝	PA.SW	Si.T	100	5	7 A	40W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	100	100	2000~ 15000	3	3 A			$t_{on} = 0.8 \mu\text{S}$, $t_f = 2.5 \mu\text{S}$							268	ターリントン
" 634	"	"	"	80	5	7 A	40W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	100	80	2000~ 15000	3	3 A			$t_{on} = 0.8 \mu\text{S}$, $t_f = 2.5 \mu\text{S}$							268	ターリントン
" 635	"	"	"	60	5	7 A	40W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	100	60	2000~ 15000	3	3 A			$t_{on} = 0.8 \mu\text{S}$, $t_f = 2.5 \mu\text{S}$							268	ターリントン
" 636	松 下	PA	Si.EP	30	7	100	400	135	1	20	250	10	2	5	-2	250	5 k	0.4	20	150*	3.5	70	151	
" 637	"	"	"	60	7	100	400	135	1	20	250	10	2	5	-2	250	5 k	0.4	20	150*	3.5	70	151	
" 638	"	"	"	30	7	500	600	135	0.1	20	160	10	150	10	-50					200*	6	3.5k*	151	2SB643 とコンフリ
" 639	"	"	"	60	7	500	600	135	0.1	20	160	10	150	10	-50					200*	6	3.5k*	151	2SB644 とコンフリ
" 640	東 芝	PA	Si.TMe	600	5	7 A	100W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	100	500	25~140	5	1 A	10	-500					3*	70		102	
" 641	"	SW	"	600	5	15A	150W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	500	500	20~140	5	5 A	10	-500	$t_{on} = 0.8 \mu\text{S}$, $t_f = 0.6 \mu\text{S}$				4*	150		102	
" 642	"	"	"	600	5	40A	300W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	1mA	600	>10	5	30A			$t_{on} = 1.2 \mu\text{S}$, $t_f = 0.8 \mu\text{S}$					400		266	
" 643	"	"	"	300	5	30A	300W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	600	300	>150	5	30A			$t_{on} = 1 \mu\text{S}$, $t_f = 3.5 \mu\text{S}$					450		266	ターリントン
" 644	"	"	"	600	5	30A	300W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	600	600	>150	5	30A			$t_{on} = 1.5 \mu\text{S}$, $t_f = 5 \mu\text{S}$					350		266	ターリントン
" 645	"	"	"	600	5	30A	350W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	600	600	>150	5	30A			$t_{on} = 1.5 \mu\text{S}$, $t_f = 5 \mu\text{S}$							319	ターリントン
" 646	"	"	"	600	5	50A	400W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	1mA	600	>150	5	50A			$t_{on} = 1.5 \mu\text{S}$, $t_f = 5 \mu\text{S}$					600		319	ターリントン
" 647	"	"	"	800	5	100A	770W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	125	2mA	800	>100	5	100A			$t_{on} = 3 \mu\text{S}$, $t_f = 15 \mu\text{S}$							158	ターリントン
" 648	"	"	"	300	4	400A	2500W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	125	10mA	300	400	5	400A			$t_{on} = 1 \mu\text{S}$, $t_f = 2 \mu\text{S}$							156	ターリントン
" 649	"	"	"	1500	5	3 A	22W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	115	100	750	7	10	3 A			$t_f < 0.9 \mu\text{S}$							102	
" 650	日 立	"	Si.T	400	7	6 A	80W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	5	300	>500	2	4 A			$t_{off} < 16 \mu\text{S}$							102	ターリントン
" 651																								
" 652																								
" 653																								
" 654	三 菱	PA	Si.EP	50	5	500	570	150	0.1	30	100	10	1	10	-30					190*	15		84B	
" 655	日 立	AF.PA	Si.E	30	5	700	500	150	1	20	250~1200	1	150	1	-150					250*			138	
" 656	東 芝	PA	Si.T	200	5	1.5A	30W ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	150	10	150	40~180	10	500	10	-500					>2*			99	